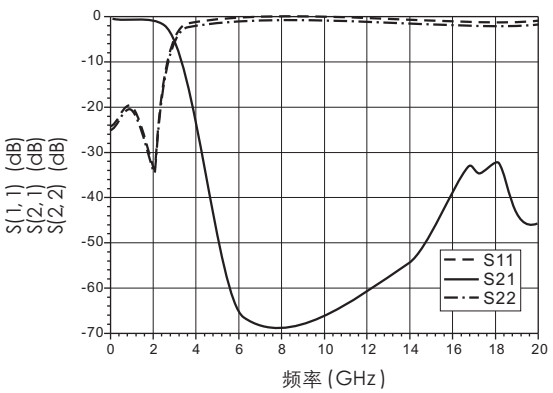
性能特点

- 通带频段：DC～2.5GHz
- 通带插损：≤ 2.2dB
- 阻带衰减：≥20dB@4.0GHz
  ≥40dB@4.8~18GHz
- 驻 波 比：≤1.3:1
- 接　　口：50Ω共面波导线

概述

BWLF-2R5是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点，广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现，性能不受外部盒体影响，使用简单方便。芯片尺寸2.1x1.05 x 0.1mm。

典型曲线（T_A=+25℃）

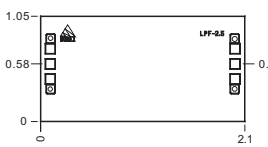


极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65~+150℃
使用温度	-55~+125℃

ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

外形尺寸

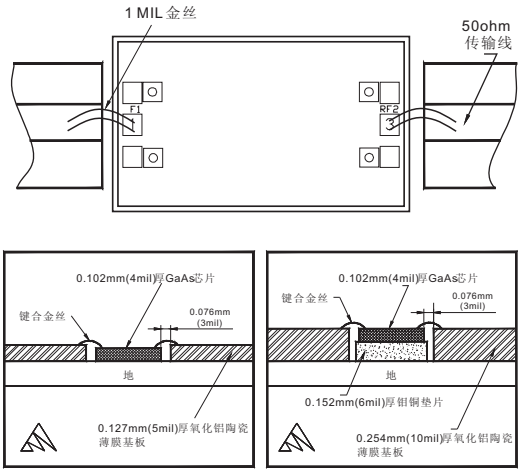


说明：

1.单位：毫米，
公差：±0.05mm
2.芯片背面镀金、接地
3.键合压点镀金，
压点尺寸：0.1×0.1(mm)
4.不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注:陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是0.076~0.152mm(3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。
清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。
静电防护：请严格遵守ESD防护要求，避免器件静电损伤。
常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。
装架操作：芯片安装可采用AuSn焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。
烧结工艺：推荐使用金锡比例80/20的AuSn焊料片。工作面温度达到255℃，工具（真空夹头）温度达到265℃。当高温混合气体（氮气氢气比例为90/10）吹到芯片时，工具顶端的温度要提高到290℃。不要让芯片在高于320℃温度下超过20秒钟。摩擦时间不要超过3秒钟。
粘接工艺：导电胶的点胶量要尽量少，将芯片放置于安装位置后在其四周可见导电胶即可。固化条件参考导电胶厂商提供的资料。
键合操作：球形或楔型键合均采用Φ0.025mm(1mil)金丝。热超声键合温度150℃。球形键合劈刀压力40~50gf，楔形键合劈刀压力18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。